FORMING METHOD OF WIRING PATTERN, MANUFACTURING METHOD OF CIRCUIT BOARD, AND MANUFACTURING METHOD OF TRANSLUCENT BODY FORMING LIGHT-SHIFL DING PATTERN THEREIN

Publication number: JP2002134878 Publication date: 2002-05-10

Inventor: OGUCHI TOSHIHIKO; SUGANAMI KEIKI

Applicant: MORIMURA CHEMICALS LTD

Classification:

- international: B41J2/01; G03F7/20; H05K3/10; H05K3/24; B41J2/01;

G03F7/20; H05K3/10; H05K3/24; (IPC1-7): H05K3/10;

B41J2/01; G03F7/20; H05K3/24

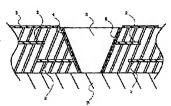
- european: Application number: JP20000326114 20001025

Priority number(s): JP20000326114 20001025

Report a data error here

Abstract of JP2002134878

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method of a wiring pattern in which a fine pattern is directly formed on a substrate and the like, to provide a manufacturing method of a circuit board, and to provide a manufacturing method of a translucent body in which a light-shielding pattern is formed. SOLUTION: Using an ink let device, a circuit pattern is drawn on a substrate with a metal fine particle ink in which metal fine particles whose average particle size is 100 nm or less are dispersed in water or organic solvent. Then, the substrate is processed with a heat or light ray to resolve/volatilize the polymer or surfactant contained in the circuit pattern to constitute a conductor pattern of a prescribed film thickness. Since a pattern is directly drawn with the ink jet device, an equipment cost and a production cost are low.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51) Int.Cl.1

(19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-134878 (P2002-134878A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成14年5月10日(2002.5.10)

H05K	3/10		H05K	3/10		D 2	C 0	5 6
B41J	2/01		G03F	7/20	501	2	ΗO	97
G03F	7/20	501	H05K	3/24		C 5	E 3	43
H05K	3/24		B41J	3/04	101	Y		
					101	Z		
			審查請求	未請求	請求項の数7	OL	(全	5頁)
(21)出願番号 特職2000-328114(P2000-326114)		(71)出職人	0001919	62				
				森村ケ	ミカル株式会社			
(22) 出顧日		平成12年10月25日(2000.10.25)		東京都洋	株区虎ノ門1丁	33番:	月	森村ビ
				ル				
			(72)発明者	小口 1	李			
				東京都洋	佐成虎ノ門1丁	33番	号	森村ビ
				ル森	オケミカル株式会	社内		
			(72)発明者	賞波 有	政客			
				東京都洋		33書	月	森村ビ
				ル森	オケミカル株式の	会社内		
			(74)代理人	1000778	49			
				弁理士	須山 佐一			
							最終	質に続く

FΙ

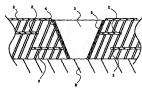
(54) [発明の名称] 配算パターンの形成方法、回路基板の製造方法および遮光パターンの形成された透光体の製造方 抾

(57)【要約】

【課題】 基板等の上に直接ファインパターンを形成で きる配線パターンの形成方法、回路基板の製造方法およ び遮光パターンの形成された透光体の製造方法を提供す るとと.

微別記号

【解決手段】 基体上に、インクジェット装置を用い て、平均粒子径が100nm以下の金属微粒子を水また は有機溶剤中に分散させた金属微粒子インクにより、同 路パターンを描画し、次いで該基板を熱もしくは光線に より処理して前記回路バターンに含まれる重合体または 界面活性剤を分解揮散させて所望の膜厚の導体パターン とする。インクジェット装置を用いて直接パターンを描 画するので設備費や生産コストを安価にすることができ る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に、インクジェット装置を用い て、平均粒子径が100nm以下の金属微粒子を水また。 は有機溶剤中に分散させた金属微粒子インクにより、回 路パターンを描画し、次いで該基板を熱もしくは光線に より処理して前記回路パターンに含まれる重合体または 界面活性剤を分解揮散させて所望の膜厚の導体バターン とすることを特徴とする配線パターンの形成方法。

1

【請求項2】 基体上に、インクジェット装置を用い て、平均粒子径が100nm以下の金属微粒子を水また 10 は有機溶剤中に分散させた金属微粒子インクにより、回 路パターンを描画し、次いで該基板を執もしは光線によ り処理して前記回路パターンに含まれる前記重合体また は界面活性剤を分解揮散させて所望の隙厚に足りない薄 い導体パターンを形成し、しかる後前記薄い導体パター ンをメッキ核として導電金属による電解メッキを施し所 望の膜厚の導体パターンとすることを特徴とする配線パ ターンの形成方法。

【請求項3】 前記金属微粒子が、Au、Pt、Ag、 Cu、Ni、Cr、Rh、Pd、Zn、Co、Mo、R 20 がかさむ、という問題もある。 u. W. Os. Ir. Fe. Mn. Ge. Sn. Ga to よびInから選ばれた一種以上からなることを特徴とす る請求項1記載の配線パターンの形成方法。

【請求項4】 前記金属微粒子が重合体または界面活性 剤で被覆されていることを特徴とする請求項1乃至3の いずれか一項記載の配線パターンの形成方法。

【請求項5】 前記金属微粒子が、ポリエステル、ポリ アクリルニトリル、ポリアクリル酸エステル、ポリウレ タンとアルカノールアミンとのブロック共電合体で被覆 されていることを特徴とする請求項1万至3のいずれか 30 【0006】一方、オーバーヘッドプロジェクター(0 一項記載の配線パターンの形成方法。

【請求項6】 絶縁基板上に、請求項1乃至4のいずれ か一項記載の方法により配線パターンを形成することを 特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項7】 透明基板上に、平均粒子径が100nm 以下の金属微粒子を重合体溶液中に分散させたペースト により、進光パターンを構画することを特徴とする進光 パターンの形成された透光体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001] 【発明の属する技術分野】本発明は、配線パターンの形 成方法、回路基板の製造方法および遮光バターンの形成 された透光体の製造方法に係り、特に、基体上に、イン クジェットヘッドを用いて、金属ベーストにより直接回 路バターンを構画するようにした配線バターンの形成方 法、回路基板の製造方法および遮光パターンの形成され た透光体の製造方法に関する。

[00002]

【従来の技術】従来から、回路基板の製造方法として、 例えば、次のような方法が知られている。

- (1) 銅張り積層板上に、レジストを被覆し、フォトリ ソグフィ法により、同路パターンの露光、未露光レジス トの溶解除去、レジスト除去部のエッチングにより銅線 パターンを形成する方法。
- (2) セラミックス基板上にスクリーン印刷により導電 ベーストを所望の回路パターンに印刷し、非酸化雰囲気 中で熱処理して運電ベースト中の金属微粒子を焼結して 漢電パターンを形成する方法。
- (3) 絶縁基板上に、導電金属の蒸着により薄膜の導電 層を形成し、この導電層上に、レジストを被覆し、フォ トリソグフィ法により、回路パターンの露光、未露光レ ジストの溶解除去、レジスト除去部のエッチングにより 観線パターンを形成する方法。
- 【0003】しかしながら、(1)の銅張り積層板を用 いる方法は、幅広の配線バターンを形成する目的には適 しているが、ファインパターンの形成には不向きであ り、しかもレジストの溶解や細箔のエッチングが必要な ため麻液処理の必要があり、環境上の問題が派生する歳 れがある。また、工程数が多いため設備費や生産コスト
- [0004](2)のスクリーン印刷による方法は、ス クリーンのメッシュを細かくするには強度の占から制約 があり、このためファインパターンの形成には不向きで ある、という問題がある。
- 【0005】さらに、(3)の蒸着薄膜をエッチングす る方法では、 薄魔の漢電層のエッチングが必要なため廃 液処理の必要があり、環境上の問題が派生する虞れがあ る。また、工程数が多いため設備費や生産コストがかさ む、という問題もある。
- HP) のような画像投射装置の投射原稿は、透明フィル ム上に文字や図形等のパターンを複写機により複写して 作成されているが、 複写機のトナーは合成樹脂にカーボ ンブラックを配合し造粒したものであって遮光性が十分 ではないため、投射された映像のコントラストが不十分 であるという問題がある。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】前述した通り、従来か ら、回路基板の製造方法として、銅張り積層板を用いる

- 40 方法、スクリーン印刷による方法、蒸着薄膜をエッチン **グする方法等が知られているが、銅張り積層板を用いる** 方法やスクリーン印刷による方法には、ファインパター ンの形成ができない、廃液処理の必要がある、設備費や 生産コストがかさむという問題があり、蒸着薄膜をエッ チングする方法には、廃液処理の必要があり、設備費や 生産コストがかさむという問題があった。
- 【0008】また、従来のOHPのような画像投射装置 の投射原稿は、遮光性が十分ではないため投射された映 像のコントラストが不十分であるという問題があった。 50 【0009】本発明はかかる従来の問題を解消するため

になされたもので、ファインパターンの形成が容易で、 廃液処理の必要がなく、生産工程が単純で設備費や生産 コストが少なくて済む配線パターンの形成方法および同 路基板の製造方法ならびに遮光性に優れコントラストの 良好な投射映像が得られる遮光パターンの形成された透 光体の製造方法を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】基体上に、インクジェッ ト装置を用いて、平均粒子径が100mm以下の金属微 粒子を水または有機溶剤中に分散させた金属儀粒子イン 10 クにより、回路パターンを描画し、次いで該基板を熱も しくは光線により処理して前記回路パターンに含まれる 重合体または界面活性剤を分解揮散させて所望の膜厚の 導体パターンとすることを特徴とする。

【0011】本発明において導体バターンを形成する基 体としては、用途に応じて任意のものを使用することが できる。

【0012】回路基板を製造する場合には、後述する熱 処理に耐え得る材質の基体であれば特に制限はない。

は、ポリイミドフィルム、ポリアミドイミドフィルム、 ポリアミドフィルム、ポリエステルフィルム、ガラスー エポキシ基板、紙-フェノール基板、シリコン基板、セ ラミックス基板、ガラス基板等が例示される。

【0014】基体として有機質材料からなるフィルムや 基板を使用する場合には、金属微粒子インクの重合体と しては、この基材の軟化点より低い温度で分解揮散す る、例えばウレタン系の重合体が適している。

【0015】回路基板を製造する場合には、特に、耐熱 性、電気絶縁性の優れたポリイミドフィルム、ポリアミ 30 ドイミドフィルム、ガラスーエポキシ基板、紙ーフェノ ール基板、セラミックス基板、ガラス基板等が適してい る。

[0016]また、OHPのような画像投射装置に用い る遮光バターンの形成された透光体を製造する場合に は、無色で透明度の高いポリエステルフィルムやガラス 基板等が適している。

【0017】本発明に用いられる金属微粒子としては、 Au, Pt. Ag, Cu, Ni, Cr, Rh, Pd, Z n. Co. Mo. Ru. W. Os. Ir. Fe. Mn. Ge、Sn、Ga、In等があげられるが、特に、A u、Ag、Cuのような金属の微粒子を用いると、電気 抵抗が低く、かつ驚食に強い同路パターンを形成すると とができるので好ましい。

【0018】本発明において、金属微粒子インクに用い られる重合体または界面活性剤は、金属微粒子の保護コ ロイドとして作用するものであり、特に、ポリエステ ル、ポリアクリルニトリル、ポリウレタンとアルカノー ルアミンとのブロック共重合体が好適している。

クと油系用インクがある。

【0020】金属微粒子を、水を主体とする分散媒に分 散せしめてなる水性インクは、例えば、次のような方法 で調整するととができる。

【0021】すなわち、塩化金酸や硝酸銀のような金属 イオンソース水溶液に水溶性の重合体を溶解させ、撹拌 しながちジメチルアミノエタノールのようなアルカノー ルアミンを添加する。数10秒~数分で金属イオンが還 元され、平均粒系100mm以下の金属微粒子が析出す る。塩素イオンや硝酸イオンを限外ろ過などの方法で除 去した後、濃縮・乾燥することにより濃厚な金属微粒子 インクが得られる。この金属微粒子インクは、水やアル コール系溶媒、テトラエトキシシランやトリエトキシシ ランのようなゾルゲルプロセス用バインダーに安定に溶 解・混合することが可能である。

[0022]金属粒子を油を主体とする分散媒に分散せ しめてなる油性インクは、例えば、次のような方法で課 整することができる。

【0023】すなわち、油溶解性のポリマーをアセトン 【0013】すなわち、本発明に用いられる気体として 20 のような水混和性有機溶媒に溶解させ、この溶液を金属 イオンソース水溶液と混合する。混合物は不均一系であ るが、これを撹拌しながらアルカノールアミンを添加す ると金属後約子は重合体中に分散した形で油相側に析出 してくる。とれを継条・濃縮・乾燥させると水系と同様 の濃厚な金属微粒子インクが得られる。との金属微粒子 インクは、芳香族系、ケトン系、エステル系などの溶媒 やポリエステル、エボキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリウ レタン樹脂等に安定に溶解・混合するととが可能であ

> 【0024】金属微粒子インクの分散媒中における金属 微粒子の濃度は、最大80重量%とすることが可能であ るが、用途に応じて適宜稀釈して使用する。

【0025】 通常、金属微粒子インクにおける金属微粒 子の含有量は2~50重量%、界面活性剤および樹脂の 含有量は0.3~30重量%、粘度は3~30センチボ イズが適当である。

【0026】本発明に使用するインクジェット装置とし ては、サーマル方式、ピエゾ方式のいずれも使用可能で ある。ただ、前者は分散媒の突縛現象を利用して金属微 40 粒子インクを噴射するので、使用する金属微粒子インク としては、抽性インクよりも水系性インクの方が適して

【0027】現在、公知のインクジェット装置の解像度 は、2000DPIに達しているので、本発明によれば 6 μmの線幅のパターンを形成することが可能である。 【0028】次に本発明において回路パターンを導電バ ターンとして用いて回路基板を形成する方法について説 明する。

【0029】まず、用途に応じて選択された正常な絶縁 [0019] 本発明の金属微粒子インクは、水系用イン 50 装板上に、インクジェット装置を用いて所定の厚さの回 路パターンを形成する。

【0030】次に、例えば100℃のオーブン中で3分 間程度加熱して乾燥させ、さらに150~300℃のオ ープン中に15~30分間程度置いて重合体を分解揮散 させるとともに金属微粒子を燃結させて漢電パターンを 形成する。

【0031】以上の工程によってバターンを構成してい る金属後粒子は相互に接着して導電性の皮膜膜に変化し て導電回路が形成される。

【0032】また、必要に応じて上記工程で得られた導 10 電回路をメッキ核として、常法による電解メッキを施せ は、厚膜の導電回路パターンを形成することも可能であ る。このようにして得られる導電パターンの比抵抗値は 10-5~10-6Qcmであり、回路基板として十分使用 することが可能である。

【0033】また、遮光パターンを形成するには、上記 の焼結工程を省略することも可能である。本発明により 形成された同路パターンは遮光性に優れており、コント ラストの優れたOHP用の原稿やマスクを得ることがで きる.

[0034]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施例について説明 する。

【0035】実施例1

Ag含有率20重量%のAg微粒子インク(Agの平均 粒系10nm、保護コロイド樹脂5歳量%含有のイソプ ロビルアルコール分散体)をプロビレングリコールモノ メチルアセテートに固形分遣度が15重量%となるよう に溶解し、ピエゾ方式のインクジェット装置を用いてボ リイミドフィルム上に線幅20μm、膜厚3μmの回路 30 パターンを描画し、150℃で15分間乾燥させた。

【0036】次に、200°Cで40分間の焼き付けを行 って導体パターンを形成した。得られた導体パターンの 抵抗値は2×10-5Ω cmであり、回路基板として使用可 能であることが確認できた。

[00371 実施例2

Ag微粒子インクに変えてAu粒子インク(Au粒子平 均系100nm. Au粉子含有塞30重量%薄コロイド 含有率10重量%の水分散体)を用いて同様にビエゾ方 式インクジェットによりガラス板上に線幅50μm、膜 40 厚1μmの導電性同路パターンを作製し、同様に乾燥・ 焼き付けを行ったところ、配線回路の電気抵抗が3×1 0-4Q cmの配線パターンを形成できた。

【0038】実施例3

平均粒径20mmのAg像粒子5重量% (保護コロイド 1. 5重量%を含む) 平均粒径50nmのPd微粒子1 5 重量% (保護コロイド3 重量%を含む)を含む水系イ ンクをサーマル式インクジェット装置を用いてポリイミ ドフィルム上に線幅10μm、膜厚0.5μmの回路バ ターンを形成し、100°Cで15分開乾燥させた。得ら れたパターンに紫外線を照射して保護コロイド樹脂を分 解揮散させたのち、 銅の無電解メッキ浴に海漕して銅膜 厚5 μmの配線パターンを形成したところ、配線回路の 電気抵抗が3×10-5Qcmの配線パターンを形成でき tc.

【0039】実施例4

との実施例は、本発明を多層配線基板のスルーホールに 適用した例である。

【0040】図1に示すように、ポリイミド絶縁層1内 に実施例3 で使用した水系インクおよび方法を用いて多 層に線幅10μm、膜厚0.5μmの回路パターン2を 形成したのち、各回路バターン2の層間接続部が露出す るように逆円錐状の透孔3を形成し、この透孔内に同じ 水系インクを用いて、サーマル式インクジェット装置に より続厚0.5μmの塗膜4を形成し、100°Cで15 分間乾燥させた。

【0041】得られた途膜4に紫外線を照射して保護コ 20 ロイド樹脂を分解揮散させたのち、鰯の無電解メッキ浴 に浸漬して原厚5 umの銅膜からなるスルーホール5が 得られた。

【0042】実施例5

実施例2のインクおよび方法を用いて透明ポリエステル フィルム上に描画して、OHP用の投射原稿を作成し た。この投射原稿による投射像は通常のインクジェット インクにより作成した投射原稿と比べてきわめて鮮明で 高い解像度とコントラストを有するものであり、高温高 湿下に長期間保存しても全く画像が劣化しなかった。 [0043]

(発明の効果)以上説明したように本発明によれば、基 板等の上に従来達成出来なかった導電性のファインパタ ーンを形成きわめて高精度にかつ迅速に形成することが できる。また、回路の形成や投光画像の形成を完全なド ライプロセスで行うことができる。本発明はまた、従来 必要とされていた。レジスト腺の塗布や露光、現像、メ ッキなどのプロセスを経ずに廃液処理を必要とせずに導 **電性の同路を形成できる。さらに本発明は、廃液処理な**

どの問題を大幅に軽減できるので、設備費や生産コスト 【図面の簡単な説明】 【図1】 図1は、本発明の回路基板のスルーホールの

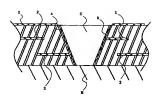
の低減に着しく寄与するものである。

部分を模式的に示す断面図である。 【符号の説明】

1……ポリイミド絶縁層、2……回路パターン、3…… …逆円錐状の透孔、4……塗膜、5……スルーホール

5

【図1】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2C056 FB05 FC01 2H097 LA09

2H097 LA09 5E343 AA07 AA18 AA34 BB22 BB23 BB24 BB25 BB38 BB39 BB40 BB43 BB44 BB48 BB49 BB72 BB80 D014 D033 EE42 ER33 GC08